# 3. Электростатика проводников. Конденсаторы

К проводникам относятся твердые тела, имеющие достаточно большую концентрацию свободных носителей электрического заряда и обладающие высокой удельной проводимостью (удельная проводимость, или электропроводность, есть величина обратная удельному сопротивлению). Хорошими проводниками являются металлы, где свободными носителями заряда являются электроны проводимости – коллективизированные валентные электроны атомов, образующих кристаллическую решетку металла. Для металлов концентрация свободных электронов

$$N_a \sim 10^{28} \text{m}^{-3}$$

а удельная проводимость

$$\sigma \sim 10^8 - 10^{10} \text{ Om}^{-1} \text{m}^{-1}$$
.

Если куску металла передать электрический заряд, то под действием кулоновских сил отталкивания он распределится в тонком поверхностном слое толщиной  $\sim 10^{-10} \mathrm{M}$  металла таким образом, что электрическое поле внутри всего металла равняется нулю. При этом потенциал во всех точках металла имеет одинаковую величину. В случае металлического шара радиуса R переданный ему заряд q равномерно распределится по всей поверхности шара с постоянной **поверхностной плотностью** 

$$\sigma = \frac{dq}{dS} = \frac{q}{4\pi R^2} \ .$$

Вектор напряженности электрического поля, созданного этими поверхностными зарядами, описывается формулой:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & R > r \ge 0; \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}, & \infty > r > R, \end{cases}$$

где  $\vec{r}$  - радиус-вектор точки наблюдения, проведенный из центра шара.

Если кусок металла поместить в постоянное электрическое поле  $\vec{E}$  , то под действием силы

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

начнется пространственное перераспределение свободных электрических зарядов. Это перераспределение зарядов закончится только тогда, когда суммарное поле  $\vec{E}_{\text{сум}}$  внутри металла станет равным нулю

$$\vec{E}_{\scriptscriptstyle \rm CYM} = \vec{E} + \vec{E}' = 0 \ . \label{eq:EYM}$$

Здесь  $\vec{E}'$  - вектор напряженности электрического поля, созданного перераспределенными зарядами, которые разместились в тонком поверхностном слое металла. В случае металлического шара распределение этих зарядов, индуцированных внешним электрическим полем  $\vec{E}$ , показано на рис. 3.1. Отметим, что суммарное поле вне шара отлично от нуля.

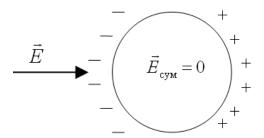


Рис. 3.1

**Конденсатор** есть система из двух проводников, разделенных непроводящей областью. Если на один из проводников подать положительный заряд q, а на другой проводник - отрицательный заряд -q, то между проводниками возникнет разность потенциалов

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{C} .$$

Здесь C - емкость конденсатора, зависящая от его геометрических параметров и свойств непроводящей области.

При зарядке конденсатора совершается работа, связанная с пространственным разделением зарядов противоположного знака. Эта работа определяет энергию заряженного конденсатора

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}Cu^2 ,$$

где  $u = \phi_1 - \phi_2$  - электрическое напряжение на конденсаторе.

Носителем энергии заряженного конденсатора является электрическое поле, созданное его зарядами. Энергия электрического поля, приходящаяся на единицу объема, называется плотностью энергии электрического поля и в случае вакуума описывается формулой

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 .$$

Соответственно полная энергия электрического поля заряженного вакуумного или воздушного конденсатора имеет вид:

$$W = \int \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV ,$$

где интегрирование проводится по всему объему V конденсатора (за пределами конденсатора электрическое поле можно считать равным нулю).

В зависимости от формы проводников, называемых обкладками конденсатора, различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

## Задача №7

Сферический конденсатор образован двумя концентрическими проводящими сферами с радиусами  $R_1$  и  $R_2 > R_1$ . Внутренней сфере сообщили заряд +q, а внешней -q (рис. 1). Определите: 1) разность потенциалов  $\phi_1 - \phi_2$  между обкладками конденсатора, 2) емкость C конденсатора и 3) энергию W электрического поля конденсатора.

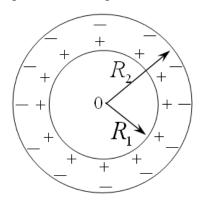


Рис. 1 Решение

Из решения задачи №4 следует, что вектор напряженности электрического поля заряженного конденсатора описывается выражением:

$$\vec{E} = \begin{cases} 0, & R_1 > r \ge 0; \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}, & R_2 > r \ge R_1; \\ 0, & \infty > r \ge R_2. \end{cases}$$
 (1)

3десь  $\vec{r}$  - радиус-вектор, проведенный из центра 0 конденсатора в точку наблюдения.

Разность потенциалов между положительно заряженной внутренней обкладкой и отрицательно заряженной внешней обкладкой имеет вид:

$$\phi_{1} - \phi_{2} = \int_{1}^{2} (\vec{E}\vec{\tau}) dl = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}} (\vec{r} \cdot \vec{r}) dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} (\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{R_{2} - R_{1}}{R_{1}R_{2}}$$
(2)

Здесь интегрирование выполняется вдоль силовой линии электрического поля, представляющей собой прямую, начинающуюся на внутренней обкладке в точке 1 и заканчивающуюся на внешней обкладке в точке 2. При этом продолжение силовой линии проходит через центр конденсатора. Поскольку обкладки конденсатора есть эквипотенциальные поверхности, где во всех точках  $\phi_1$ =const и  $\phi_2$ =const, то для расчета разности потенциалов можно выбрать любой путь интегрирования, соединяющий эти обкладки.

Согласно определению емкости конденсатора

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{C} \tag{3}$$

и формуле (2) емкость сферического конденсатора

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = 4\pi \varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \ . \tag{4}$$

Энергия электрического поля конденсатора распределена в области между обкладками конденсатора и описывается выражением:

$$W = \int_{V} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{q}{(4\pi\varepsilon_0)^2} \frac{1}{r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} = \frac{q^2}{2C}$$
 (5)

Otbet: 
$$\phi_1 - \phi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$$
,  $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ ,  $W = \frac{q^2}{2C}$ .

#### Задача №8

Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин S и расстоянием d между ними подключен к источнику с постоянной ЭДС  $\varepsilon$ . В конденсатор параллельно его обкладкам вдвигают незаряженную проводящую пластину толщиной l < d (рис.1). Определите: 1) электрические заряды +q' и -q'', индуцированные на поверхности пластины; 2) напряженность электрического поля E во всем пространстве; 3) емкость C' полученной системы пластин.

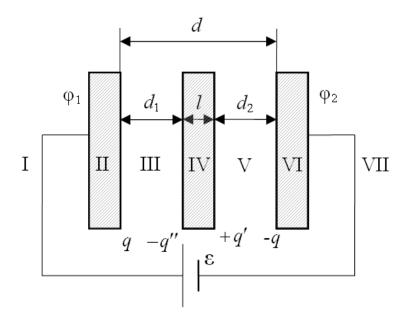


Рис.1

#### Решение

При внесении пластины в заряженный конденсатор его электрическое поле индуцирует на поверхностях пластины положительный заряд q' и отрицательный заряд -q''. Поскольку в пластине происходит только пространственное разделение зарядов и она остается электрически нейтральной, то

$$q' - q'' = 0, \quad q' = q''$$
 (1)

В случае однородного электрического поля плоского конденсатора индуцированные заряды равномерно распределены по соответствующим поверхностям пластины с плотностями

$$\sigma' = \frac{q'}{S}, \quad \sigma'' = \frac{q''}{S} = -\frac{q'}{S} = -\sigma'.$$
 (2)

Величина заряда q' находится из условия равенства нулю полного электрического поля  $E_{\rm IV}$  внутри внесенной пластины. Это поле создают 4 параллельные равномерно заряженные плоскости, показанные на рис.1. Векторы напряженности соответствующих электрических полей перпендикулярны поверхностям пластин, а их величины определяются поверхностной плотностью заряда  $\sigma$  в соответствии с формулой

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. ag{3}$$

Здесь для приближенного описания E используется формула, справедливая, строго говоря, только для неограниченной заряженной плоскости.

С учетом (2) и (3) напряженность полного электрического поля внутри внесенной пластины запишется в виде:

$$\frac{q}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q'}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q'}{2\varepsilon_0 S} + \frac{q}{2\varepsilon_0 S} = 0. \tag{4}$$

Отсюда находим, что

$$q' = q. (5)$$

При выполнении равенства (5) электрическое поле, созданное индуцированными зарядами внутри внесенной пластины, полностью компенсирует электрическое поле, созданное зарядами +q и -q на пластинах конденсатора.

С помощью (3) и (5) можно найти напряженность электрического поля во всем пространстве:

$$E_{\rm I} = 0, \qquad E_{\rm III} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}, \qquad E_{\rm IV} = 0, \qquad E_{\rm V} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}, \qquad E_{\rm VI} = 0, \qquad E_{\rm VII} = 0.$$
 (6)

Разность потенциалов между положительно заряженной пластиной и отрицательно заряженной пластиной конденсатора описывается выражением:

$$\phi_{1} - \phi_{2} = \int_{1}^{2} (\vec{E}\vec{\tau})dl = E_{III}d_{1} + E_{V}d_{2} = \frac{q}{\varepsilon_{0}S}(d_{1} + d_{2}) = \frac{q}{\varepsilon_{0}S}(d - l) = \frac{q}{C'}.$$
 (7)

Здесь интегрирование ведется вдоль силовой линии электрического поля конденсатора, начинающейся в точке 1 на поверхности положительно заряженной пластины и оканчивающейся в точке 2 на поверхности отрицательно заряженной пластины.

Таким образом, емкость системы пластин

$$C' = \frac{\varepsilon_0 S}{d - l} \tag{8}$$

Это эквивалентная емкость двух последовательно соединенных плоских конденсаторов с расстояниями между пластинами  $d_1$  и  $d_2$  при одинаковой площади пластин S.

Согласно условиям задачи разность потенциалов на пластинах конденсатора определяется величиной ЭДС є источника

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varepsilon = \frac{q}{C} , \qquad (9)$$

поэтому

$$q = C\varepsilon = \frac{\varepsilon_0 S}{d - l}\varepsilon\tag{10}$$

и с учетом (6)

$$E_{\text{III}} = E_{\text{IV}} = \frac{\varepsilon}{d-l}$$
.

Otbet: 
$$q' = q'' = \frac{\varepsilon_0 S}{d-l} \varepsilon$$
,  $E_I = E_{II} = E_{IV} = E_{VII} = E_{VII} = 0$ ,  $E_{III} = E_V = \frac{\varepsilon}{d-l}$ ,  $C' = \frac{\varepsilon_0 S}{d-l}$ 

.

## Задача №9

На плоский воздушный конденсатор с площадью пластин  $S=100~{\rm cm}^2$  подается постоянное напряжение  $U=220{\rm B}$  (рис.1). Напряженность электрического поля внутри конденсатора  $E=560{\rm B/cm}$ . Определите:

- 1) поверхностную плотность о положительного заряда конденсатора;
- 2) энергию W электрического поля конденсатора; 3) силу притяжения F пластин конденсатора.

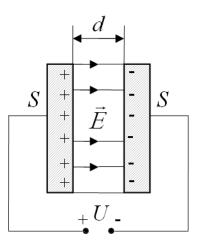


Рис. 1

### Решение

Поверхностные плотности зарядов о и -о на пластинах конденсатора можно приближенно считать одинаковыми во всех точках поверхности соответствующих пластин, поэтому электрическое поле внутри воздушного конденсатора определяется формулой для равномерно заряженной неограниченной плоскости:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \ . \tag{1}$$

Отсюда находится соответствующая поверхностная плотность положительного заряда:

$$\sigma = \varepsilon_0 E = 5.57 \cdot 10^{-7} \frac{\text{K}_{\Pi}}{\text{M}^2} \ . \tag{2}$$

Энергия электрического поля заряженного воздушного плоского конденсатора

$$W = \int_{V} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 V = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 S d , \qquad (3)$$

где V=Sd – объем области между обкладками конденсатора и d - расстояние между ними.

Расстояние d находится с помощью разности потенциалов

$$\phi_1 - \phi_2 = U = \int_1^2 (\vec{E}\vec{\tau})dl = Ed$$
(4)

где интегрирование ведется вдоль силовой линии электрического поля внутри конденсатора. Отсюда получаем, что

$$d = \frac{U}{E} \ . \tag{5}$$

С учетом (5) энергия электрического поля конденсатора (3) запишется в виде:

$$W = \frac{1}{2} \varepsilon_0 EUS = \frac{1}{2} \sigma US = \frac{1}{2} qU = 8 \cdot 10^{-7} \text{Дж} , \qquad (6)$$

где  $q=\sigma S$  - положительный заряд конденсатора.

Сила притяжения между пластинами конденсатора

$$F = \frac{1}{2}qE = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{H} . \tag{7}$$

Здесь учитывается только то электрическое поле, которое создано зарядами противоположного знака, находящимися на другой пластине конденсатора.

Ответ: 
$$\sigma = 5,7 \cdot 10^{-7} \text{ Kл/м}^2$$
,  $W = 8 \cdot 10^{-7} \text{ Дж}$ ,  $F = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ H}$ .